ПРОГРАММА
ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ

Место стажировки: Международный центр диэлектрических исследований, Сианьский транспортный университет, г. Сиань, Китай

Стажирующийся: Младший научный сотрудник отдела оптоэлектроники и полупроводниковой техники НИИ ФПМ Ушаков Андрей Дмитриевич

Сроки: с 1 по 10 ноября 2023 года,

Тема стажировки: Методы создания доменных структур в ромбоэдрических кристаллах PMN-PT, вырезанных перпендикулярно [110] направлению, для электрооптических применений

1. Ознакомление с литературными данными о доменных структурах в ромбоэдрических кристаллах PMN-PT.
2. Ознакомление с экспериментальной методикой яи оборудованием для исследования и создания доменных структур.
3. Проведение серии экспериментов по созданию доменных структур в кристаллах PMN-PT, вырезанных перпендикулярно [110] направлению.
4. Изучение полученных образцов с различными типами созданных доменных структур.
5. Измерение электрооптических коэффициентов полученных образцов.

Директор УЦКП
«Современные нанотехнологии В. Я. Шур

21.10.2023
Стажирующийся А. Д. Ушаков